

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
9. Juni 2005 (09.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/053125 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01S 5/183,**
H01L 33/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002624

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. November 2004 (25.11.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 55 357.6 25. November 2003 (25.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **TRANSMIT GESELLSCHAFT FÜR TECH-
NOLOGIETRANSFER MBH** [DE/DE]; Kerkrader
Strasse 3, 35394 Giessen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **STOLZ, Wolfgang**
[DE/DE]; Am Knechtacker 19, 35041 Marburg (DE).
LUTGEN, Stephan [DE/DE]; Weissbräuhausgasse 2a,
93047 Regensburg (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **TRANSMIT
GESELLSCHAFT FÜR TECHNOLOGIETRANS-
FER MBH**; Kerkrader Strasse 3, 35394 Giessen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: OPTICALLY PUMPED SEMICONDUCTOR DEVICES FOR GENERATING RADIATION, THE PRODUCTION
THEREOF AND METHOD FOR COMPENSATING STRAIN IN THE SERIES OF LAYERS INTEGRATED IN SAID DEVICES

(54) Bezeichnung: OPTISCHE GEPUMPTHE HALBLEITERVORRICHTUNGEN ZUR ERZEUGUNG VON STRAHLUNG UND
DEREN HERSTELLUNG SOWIE VERFAHREN ZUR KOMPENSATION VON VERSPANNUNGGEN IN DEN DARIN EIN-
GESETZTEN SCHICHTFOLGEN

(57) Abstract: The invention relates to a novel method for producing strain-compensated semiconductor layers, in addition to the
use of said layers for producing strain-compensated semiconductor layer systems and an optically pumped semiconductor device for
generating radiation, preferably long-wave radiation.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein neues Verfahren zur Herstellung verspannungskompensierender Halbleiterschichten vorge-
schlagen, sowie dessen Verwendung zur Herstellung von verspannungskontrollierten Halbleiterschichtsystemen und zur Herstellung
von optisch gepumpten Halbleitervorrichtung zur Erzeugung von Strahlung, vorzugsweise langwelliger Strahlung.



WO 2005/053125 A1